CLIPPEDIMAGE= JP359026277A

PAT-NO: JP359026277A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 59026277 A TITLE: PRODUCTION OF THERMAL HEAD

PUEN-DATE: February 10, 1984

INVENTOR-INFORMATION:
NAME
TAKAMATSU, YASUHIKO
SUGANO, OSAMU
YAMAGUCHI, TAKAYUKI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

RICOH CO LTD

COUNTRY N/A

APPL-NO: JP57135932

APPL-DATE: August 4, 1982

INT-CL_(IPC): B41J003/20; H01L049/00

JS-CL-CURRENT: 219/216,347/200

ABSTRACT:

PURPOSE: To prevent a plated metal layer from being delaminated, by a method wherein a pattern of a photoresist layer is provided in a region including an abrasion-resistant layer and excepting a bonding part of an electrode, and the electrode is plated with gold by using the photoresist pattern as a mask.

CONSTITUTION: A tantalum nitride layer 10, a nichrome layer 11, a gold layer 12 and the plated gold layer 13 are provided in four layers on a ceramic substrate 1 by appropriate means, thereafter the layers are patterned to produce a heating resistor and the electrode. Then, a silicon dioxide layer 14 as a protective layer and a tantalum pentoxide layer 15 as the abrasion-resistant layer are provided in two layers by a mask sputtering method. Subsequently, a

03/25/2002, EAST Version: 1.03.0002

photoresist is applied to the entire upper surface of the thermal head in this condition, is then exposed to light through a mask, and is developed so that the photoresist remains in the area of the pattern 20.

COPYRIGHT: (C)1984,JPO&Japio

N/A 002 N/A

APPLICATION-D

(9) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭59-26277

(5) Int. Cl.³ B 41 J 3/20 H 01 L 49/00 識別記号 103 庁内整理番号 8004-2C 6370-5F **公**公開 昭和59年(1984)2月10日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

❸サーマルヘッドの製造方法

②特 願 昭57-135932

②出 願昭57(1982)8月4日

仍発 明 者 高松恭彦

東京都大田区中馬込1丁目3番 6号株式会社リコー内

②発 明 者 菅野修

東京都大田区中馬込1丁目3番

6号株式会社リコー内

⑩発 明 者 山口隆行

東京都大田区中馬込1丁目3番 6号株式会社リコー内

⑪出 願 人 株式会社リコー

東京都大田区中馬込1丁目3番

6号

砂代 理 人 弁理士 青山葆

外2名

ris 🖛 🏂

1.発明の名称

サーマルヘッドの製造方法

2.特許請求の範囲

(1) 基板上に発熱抵抗体、該発熱抵抗体の接続部上面に電極、更に上記発熱抵抗体の露出部上面及び上記電極の一部の上面に保護膜及び耐摩耗層がそれぞれパターン化されて形成された状態において、更に保護膜及び耐摩耗層を含み、少なくとも上記電極のポンデイングが行なわれる部分を除くば域にレジストパターンを形成し、該レジストパターンを形成し、該レジストパターンを形成し、また施すことを特徴とするサーマルヘッドの製造方法。

3.発明の詳細な説明

本発明はサーマルヘッドの製造方法に関し、等 に電極構造を改良した薄膜型サーマルヘッドの製 造方法に関する。

サーマルヘッドには、例えば第1図に示される ように、セラミック基板1の表面にその長手方向 に沿つて形成された発熱抵抗体2に接して、その 一方の側に駆動回路に接続される駅動用電極3、他方の側に共通電極4が形成されたもの、あるいは第2回に示されるように、発熱抵抗体2の両側に駆動用電極3と共通電極4が適当な単位で交互に繰り返して配列されるように形成されたものなどがある。5は発熱抵抗体の第世部2の全てと、駆動用電極3の一部及び共通電極4の一部を含む領域に形成された保護膜と耐摩耗層との2層構造(以下耐摩耗層等という)である。

駆動用電響3と駆動回路との接続はテープキャリア方式などの方法を用いてポンディングにより行なわれ、また共通電極4には大電流が流れる。ところで、薄膜型サーマルヘッドは薄膜形成技術により製造されるので駆動用電極3や共通電極4のような単極はせいぜい1~2μπの厚さであり、あまり厚く形成することができない。そのため、駆動用電極3へのポンディングの強度が弱く、また共通電極4に十分な電流を流すことができない問題がある。

そこで本出願人はこのようなサーマルヘッドに

おいて、更に耐敏耗胎等5をマスクとして、鳳出 している電優上にメッキにより金冶を厚く付着さ せることにより上記問題を解決する技術を開発し、 既に出願した。その方法により製造されるサーマ ルヘッドの一例の断面図は、第3図に示されるよ うれ、セラミック基板1上に発熱抵抗体となる翼 化タンタル(TaiN) 后10がパターン化されて おり、その上に区助用電極3及び共通電板4のよ うた電板としてニクロム(NiCr) 眉11、金 (Au) 店12及び金メッキ唇13がパターン化 されて形成されている。感効用電板3及び共通電 位 4 で挟まれた領域が発鳥に寄与する発鳥抵抗体 パターン2である。この発鳥抵抗体パターン2の 上部に電極3及び4の一部の上部を含んで保設膜 としての二酸化ケイ素(SiOz)層14と耐尿耗 **慰としての五段化タンタル慰(Ta₂O₅)15が形** 成されている。そしてこれら耐尽耗恐等5の外側 の鼠極3及び4上には金屑16がメッキにより形 成されている。ノッキによる金暦16は厚く形成 できるので上記の問題が解決でき、しかもこの方

ンデイング部以外の他の広い領域にも金が付着するため金の角質量が多くなり、コストアップにつながる問題がある。また保証膜14及び耐取耗層15はマスクスパッタリング法で形成するため通常その増加17は急域ではなく、なだらかな勾配をもつ。そのため駆動用電板3のパターン上で耐摩耗極等5がなだらかに変化する部分、所額だれ、

しかしながら、この方法では歐砂用電板3のポ

法は順便である利点も有している。

の部分では駅動用電板 3 のパターンのエッジ部に おつてノッキがひげ状に成長し、このひげ状の金

メッキ層が剥れ、電板間に付着して電板間で短絡 が生じる問題もある。

本発明は、従来のサーマルヘッドの電板上に更 にメッキにより金船を形成するに当り、上記不具 含を解消する方法を提供することを目的とするも のであつて、従来の方法により耐摩耗船まで形成 した後、耐摩耗局等5を含み、少なくとも電板の ポンデイング部を除いた領域にフォトレジスタを どのレジストの層のパターンを形成し、このレジ

ストパターンをマスクとして包袋上に金メッキを 施すことにより上記目的を遊成せんとするもので ある。

以下本発明の一袋施例について説明する。

第4図(N)は耐容耗層15まで形成した状態を示す断面図である。この状態までの製造工程としては、セラミック基板1上に窒化タンタル層10、ニクロム層11、金層12及び金メッキ層13を適当な手段で4層に形成した後、フォトリングラフィー技術によりパターン化を行なつて発点抵抗体と同位を形成する。次に同図のような領域に保証しての五酸化タンタル層15とをマスクスパッタリング法により2層に形成すればよい。

次化との状態のサーマルヘッドの上面全面化フォトレジストを強布した後、マスクを介して腐光し、現似して、第4図B)に示されるように、第2図の破壊で囲まれるようなパターン20にフォトレジスタを残存させる。すなわち、この状態では 塚助用は低3のポンデイング部21と共温電板4 の一部がフォトレジスト20で被徴されずK 営出 していることになる。また、フォトレジスト20 のパターン烙部22 K はだれは発生しない。

次に、同図に示されているように、このフォトレジストパターン20をマスクとして金メッキ処理を施す。メッキは電低3及び4の楽出部でのみ進行する。メッキ尼16の厚さは数μm以上、例えば7μm以上程度が好ましい。メッキ完了後、フォトレジスト階20を剥壊液にて除去すれば、果4図のに示されるような共遠電低4の一部と区別用電低3のボンデイング部21の電板腹厚が厚くなつたサーマルへッドが得られる。

なお、本発明は電枢の一部の腹関を厚くする方法に特値を有するものであるので、第4図Mの状態までは実施例のものに限定されないことは雪りまでもない。すなわち、例えば、発怒抵抗体層10としては強化タンタルの外、ニクロム、ネサ段その他既知の適当な材料を使用してもよく、また、電板構造も例示の3層構造に限らず、最上間だけが金であれば下層に他の適当な視距材料を使用す

るととも可能である。さられ、耐摩耗圏等5も、... 例示の構造以外に、炭化ケイ素(5iC)、酸化アルミニウム(Λℓ2O1)などを用いることも可能である。

以上のように、本発明によればレジスト層をお辞し、本発明によればレジスト層をお婚をいる。また、レジスト層が対象を完全に対している。また、レジスト層が対象に関係を完全に対している。また、レジスト層ののでは、だれが発生したが、仮には対し、といって、ので、がないが状に成長するようなとにはない、したがつてそのひげ状と、とともないのでは、が発生することをなり、というないが発生することをなり、というないが、というないが、したができる。

4.図面の衍草な説明

第1図及び第2図は本発明が適用されるサーマ

ルヘッドのパターンの例を示す平面図、第3図は 、 既に提案された改良されたサーマルヘッドの発熱 抵抗体近傍を示す断面図、第4図(/)ないし(7)は本 発明の工程を示す発熱抵抗体近傍の新面図である。

1…セラミック基板、2…発熱抵抗体、3,4 …電極、5…耐摩耗局等(保設膜及び耐摩耗層)、 20…レジストバターン、21…電板のポンデイ ング部、16…金メッキ層。

特許出願人 株式会社 リコー 代 囲 人 非理士 青山 葆 外2名

